

# 形 G3VM-351G

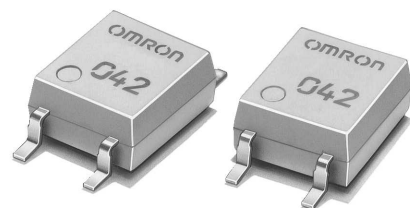
MOS FETリレー

CSM\_G3VM-351G\_DS\_J\_1\_4

MOS FETと赤外発光ダイオードを光結合させた  
高さ2.1mmの薄型ミニフラットタイプ・スモール  
アウトラインパッケージMOS FETリレー



- 形G3VM-S2シリーズをリニューアル。
- 連続負荷電流110mA。
- 入出力間耐電圧1500Vrms。



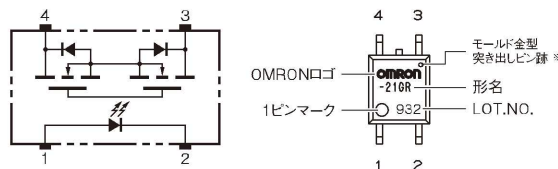
※マーキング内容については実際の商品と異なります。

RoHS適合

## ■用途例

- 半導体製造装置
- 各種計測機器
- 通信機器
- データロガー

## ■端子配置/内部接続図



注: 製品の形式表示には、「G3VM」は表示していません。  
※ 1ピンマークと対角側の窪みはモールド金型突き出しピン跡となります。

## ■種類 (○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先にお問い合わせてください)

形状	接点構成	端子種類	負荷電圧(最大) *	形式	最小梱包単位	
					スティック数量	テーピング数量
SOP4	1a	サーフェス・マウント端子	350V	○形G3VM-351G	100	—
				形G3VM-351G (TR)	—	2,500

\* 負荷電圧 (最大): ピークAC、DCを表わします。

## ■絶対最大定格 (Ta=25℃)

項目	記号	定格	単位	条件	
入力側	LED順電流	If	50	mA	
	直流順電流低減率	$\Delta I_F/C$	-0.5	mA/℃	Ta ≥ 25℃
	LED逆電圧	Vr	5	V	
出力側	接合部温度	Tj	125	℃	
	負荷電圧 (ピークAC/DC)	Voff	350	V	
	連続負荷電流 (ピークAC/DC)	Io	110	mA	
出力側	オン電流低減率	$\Delta I_O/C$	-1.1	mA/℃	Ta ≥ 25℃
	接合部温度	Tj	125	℃	
入出力間耐電圧(注1)	V <sub>I-O</sub>	1500	Vrms	AC1分間	
使用周囲温度	Ta	-40 ~ +85	℃	氷結・結露のないこと	
保管温度	Tstg	-55 ~ +125	℃	氷結・結露のないこと	
はんだ付け温度条件	—	260	℃	10s	

(注1): 入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

## ■電気的性能 (Ta=25℃)

項目	記号	最小	標準	最大	単位	条件	
入力側	LED順電圧	V <sub>F</sub>	1.0	1.15	1.3	V	If = 10mA
	逆電流	I <sub>r</sub>	—	—	10	μA	V <sub>r</sub> = 5V
	端子間容量	C <sub>T</sub>	—	30	—	pF	V = 0, f = 1MHz
	トリガLED順電流	I <sub>FT</sub>	—	1	3	mA	Io = 100mA
出力側	最大出力オン抵抗	R <sub>ON</sub>	—	25	35	Ω	If = 5mA, Io = 110mA, t < 1s
	開路時漏れ電流	I <sub>LEAK</sub>	—	—	1.0	μA	Voff = 350V
	端子間容量	C <sub>OFF</sub>	—	30	—	pF	V = 0, f = 1MHz
入出力間容量	C <sub>I-O</sub>	—	0.8	—	pF	f = 1MHz, V <sub>S</sub> = 0V	
入出力間容量絶縁抵抗	R <sub>I-O</sub>	1000	—	—	MΩ	V <sub>I-O</sub> = 500VDC, RoH ≤ 60%	
動作時間	t <sub>ON</sub>	—	0.3	1.0	ms	If = 5mA, R <sub>L</sub> = 200Ω, V <sub>DD</sub> = 20V (注2)	
復帰時間	t <sub>OFF</sub>	—	0.1	1.0	ms		

(注2): 動作・復帰時間

